

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 2 月 10 日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/012591 A1

- (51) 国際特許分類: C23C 14/34, C22C 16/00, 5/00, 9/00, 19/07, 45/02, 45/10
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010361
- (22) 国際出願日: 2004 年 7 月 14 日 (14.07.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2003-286876 2003 年 8 月 5 日 (05.08.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門二丁目 1 0 番 1 号 Tokyo (JP).

城県 亘理郡 亘理町荒浜字藤平橋 4 4-3 Miyagi (JP). 笹森 賢一郎 (SASAMORI, Kenichiro) [JP/JP]; 〒981-1505 宮城県 角田市 角田字田町 5 6-1 Miyagi (JP). 矢作 政隆 (YAHAGI, Masataka) [JP/JP]; 〒319-1535 茨城県 北茨城市 華川町臼場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ 磯原工場内 Ibaraki (JP). 中村 篤志 (NAKAMURA, Atsushi) [JP/JP]; 〒319-1535 茨城県 北茨城市 華川町臼場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ 磯原工場内 Ibaraki (JP). 高橋 秀行 (TAKAHASHI, Hideyuki) [JP/JP]; 〒319-1535 茨城県 北茨城市 華川町臼場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ 磯原工場内 Ibaraki (JP).

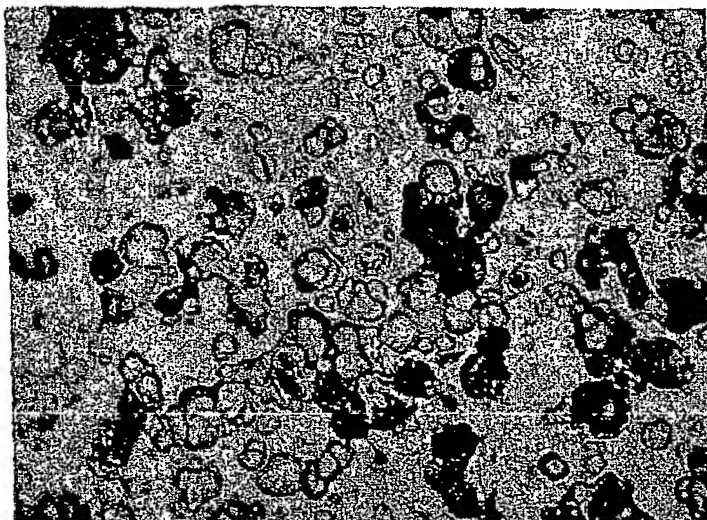
(74) 代理人: 小越 勇 (OGOSHI, Isamu); 〒105-0002 東京都 港区 愛宕一丁目 2 番 2 号 虎ノ門 9 森ビル 3 階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

[続葉有]

(54) Title: SPUTTERING TARGET AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット及びその製造方法



100 μm

(57) Abstract: A sintered sputtering target which has a structure having an average crystallite size of 1 nm to 50 nm and preferably comprises an alloy having three or more elements and containing, as a main component, at least one element selected from among Zr, Pd, Cu, Co, Fe, Ti, Mg, Sr, Y, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te and a rare earth metal; and a method for producing said target, which comprises sintering an atomized powder. The target and the method provide a target having an extremely fine and uniform structure having a high density and being produced by the sintering method, in place of a conventional bulk metal glass produced by the rapid cooling of a molten metal, which has a coarse crystal structure and requires a high cost for its production.

(57) 要約: 平均結晶子サイズが1nm～50nmの組織を備えている焼結体パツ

タリングターゲット、特に3元素以上の合金からなり、Zr、Pd、Cu、Co、Fe、Ti、Mg、Sr、Y、Nb、Mo、Tc、Ru、Rh、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Te、希土類金属から選択した少なくとも1元素を主成分とする焼結体スパッタリングターゲットに関し、該ターゲットを、アトマイズ粉を焼結することによって製造する。結晶組織が粗くコスト高となる溶湯金属の急冷によるバルク金属ガラスに替えて、焼結法による高密度の極微細で均一な組織を有するターゲットを得る。



LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。